



Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный исследовательский центр
«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»
(НИЦ «Курчатовский институт»)

пл. Академика Курчатова, д. 1, Москва, Россия, 123182

Тел.: (499)196-95-39, факс: (499)196-17-04

E-mail: nrcki@nrcki.ru, www.nrcki.ru

ОКПО 08624243, ОГРН 1027739576006,

ИНН/КПП 7734111035/773401001

Томский государственный
университет систем управления
и радиоэлектроники
Председателю диссертационного
совета 24.2.415.03
ШАНДАРОВУ С.М.

пр. Ленина, д. 40, г. Томск, 634050

03.03.2023 № *35.1.2-2993*

На № _____

О согласии выступить ведущей организацией

Уважаемый Станислав Михайлович!

В ответ на Ваш запрос от 15.02.2023 № 20/524 подтверждаю согласие федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский институт») выступить ведущей организацией по диссертации Попова А.А. на тему «Построение моделей наногетероструктурных полевых транзисторов для усилительных и управляющих функциональных блоков СВЧ монолитных интегральных схем» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальностям 1.3.5. – «Физическая электроника» и 2.2.14. – «Антенны, СВЧ-устройства и их технологии».

Соискатель и его научный руководитель не являются сотрудниками НИЦ «Курчатовский институт».

В НИЦ «Курчатовский институт» не ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени является руководителем или работником организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем).

Отзыв НИЦ «Курчатовский институт», составленный в соответствии с «Положением о присуждении ученых степеней», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842

(в действующей редакции), будет направлен в диссертационный совет не позднее 15 дней до защиты.

Необходимые сведения предоставляем, согласны на размещение этих сведений и отзыва на официальном сайте Вашей организации в сети «Интернет».

Приложение: Сведения о ведущей организации на 2 л.

С уважением,

Главный учёный секретарь Центра



К.Е. Борисов

Матюшина Наталья Леонидовна
8 (499) 196-71-00 (доб. 33-61)
Захарченко Ирина Емельяновна
8 (499) 196-71-00 (доб. 93-07)

Сведения о ведущей организации

по защите диссертации Попова А.А. «Построение моделей наногетероструктурных полевых транзисторов для усилительных и управляющих функциональных блоков СВЧ монолитных интегральных схем», представленной на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальностям «Физическая электроника» (1.3.5.) и «Антенны, СВЧ-устройства и их технологии» (2.2.14.)

Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
Ведомственная принадлежность	Правительство Российской Федерации
Сокращенное наименование организации в соответствии с уставом	НИЦ «Курчатовский институт»
Подразделение	Курчатовский комплекс перспективной атомной энергетики (ККПАЭ)
Почтовый индекс, адрес организации	123182, Москва, пл. Академика Курчатова, 1
Веб-сайт	http://www.nrcki.ru
Телефон	+7 (499) 196-33-61
Адрес электронной почты	nrcki@nrcki.ru

Список основных публикаций работников ведущей организации по тематике, близкой или смежной тематике защищаемой диссертации, в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет:

1. И.С. Езубченко, Е.М. Колобкова, А.А. Андреев, М.Я. Черных, Ю.В. Грищенко, П.А. Перминов, И.А. Черных, М.Л. Занавескин. Транзисторы с высокой подвижностью электронов на основе гетероструктур нитрида галлия для миллиметрового диапазона длин волн. Российские нанотехнологии, 2022, том 17, № 6, с.1–4.
2. И.С. Езубченко, М.Я. Черных, П.А. Перминов, Ю.В. Грищенко, И.Н. Трунькин, И.А. Черных, М.Л. Занавескин. Особенности роста гетероструктур нитрида галлия на подложках кремния: управляемая пластическая деформация. Письма в журнал технической физики, 2021, том 47, выпуск 14, с.26-29.
3. И.О. Майборода, Е.М. Колобкова, Ю.В. Грищенко, И.А. Черных, Н.К. Чумаков, М.Л. Занавескин. Контролируемое образование β - Si_3N_4 в потоке аммиака на подложках кремния, покрытых слоем нативного оксида. Кристаллография, 2021, том 66, № 3, с.474–478.

4. И.А. Черных, С.М. Романовский, А.А. Андреев, И.С. Езубченко, М.Я. Черных, Ю.В. Грищенко, И.О. Майборода, С.В. Корнеев, М.М. Крымко, М.Л. Занавескин, В.Ф. Синкевич. Мощностные характеристики нитрид-галлиевых СВЧ-транзисторов на подложках кремния. Письма в журнал технической физики, 2020, том 46, с.11-14.
5. Ю.В. Храповицкая, М.Я. Черных, И.С. Езубченко, Ю.В. Грищенко, Е.М. Колобкова, И.О. Майборода, И.А. Черных, А.А. Андреев, П.А. Перминов, М.Л. Занавескин. Технология создания СВЧ-транзисторов на основе нитрида галлия на подложках кремния в НИЦ «Курчатовский институт». Вестник ВИГ «ЭРА», 2020, том 1, № 1, с.82-85.
6. Ю.В. Храповицкая, М.Я. Черных, И.С. Езубченко, Ю.В. Грищенко, И.О. Майборода, И.А. Черных, А. А. Андреев, П. А. Перминов, М.Л. Занавескин. Мощные нитрид-галлиевые СВЧ-транзисторы на подложках кремния. Российские нанотехнологии, 2020, том15, выпуск 2, с.188-193.
7. А.А. Андреев, Ю.В. Грищенко, И.С. Езубченко, М.Я. Черных, Е.М. Колобкова, И.О. Майборода, И.А. Черных, М.Л. Занавескин. Изучение характеристик транзисторов на гетероструктурах нитрида галлия, выращенных методом аммиачной молекулярно-лучевой эпитаксии на подложках сапфира и кремния. Письма в журнал технической физики, 2019, том 45, выпуск 4, с.52-54.
8. И.С. Езубченко, М.Я. Черных, А.А. Андреев, Ю.В. Грищенко, И.А. Черных, М.Л. Занавескин. Гетероструктуры на основе нитрида галлия на подложках кремния для мощных СВЧ-транзисторов. Российские нанотехнологии, 2019, том 14, № 7-8, с.77-80.

Начальник отдела прикладных
наноэлектронных структур
НИЦ «Курчатовский институт»

М.Л. Занавескин

Подпись М.Л. Занавескина подтверждаю

Главный учёный секретарь
НИЦ «Курчатовский институт»

К.Е. Борисов

